

广东省粤晶高科股份有限公司

GUANGDONG YUEJING HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD

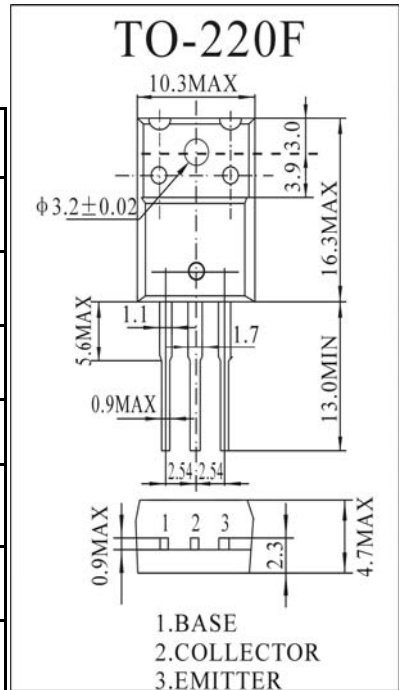
3DD3852

硅NPN双极晶体管

■ ■ 主要用途：用于彩色电视机的枕形失真校正电路等。

■ ■ MAXIMUM RATINGS(Ta=25°C) 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	符号 SYMBOL	额定值 RATING	单位 UNIT
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	V_{CBO}	80	V
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
集电极电流 Collector Current	I_C	3	A
集电极耗散功率 Collector Power Dissipation	P_C	Ta=25°C 2	W
		Tc=25°C 25	
结温 Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C



■ ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

(Ta=25°C unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为25°C)

特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITIONS	最小值 MIN.	典型值 TYP.	最大值 MAX.	单位 UNIT
集电极-基极反向截止电流 Collector Cut-off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=80V, I_E=0$	—	—	10	μA
发射极-基极反向截止电流 Emitter Cut-off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=6V, I_C=0$	—	—	10	μA
集电极-基极反向击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu A$	80	—	—	V
集电极-发射极反向击穿电压 Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1mA$	60	—	—	V
发射极-基极反向击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu A$	6	—	—	V
直流电流增益 DC Current Gain	h_{FE}	$V_{CE}=4V, I_C=0.5A$	100	—	600	—
集电极-发射极饱和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3A, I_B=0.3A$	—	—	1	V
特征频率 Gain Bandwidth Product	f_T	$V_{CE}=12V, I_C=0.2A$	7	—	—	MHz

■ ■ DEVICE MARKING 打标、分档

Classification	O	P	Q
h_{FE}	100~200	160~320	300~600